



UNIVERSITÀ DI PISA

titolo brevetto

Procedimento per la realizzazione di un rilevatore di radiazioni ionizzanti a stato solido

titolare

Università di Pisa¹

inventori

Batignani Giovanni
Giorgi Marcello
Forti Francesco

tipo di brevetto

TO 2004A000901 del 23/12/2004

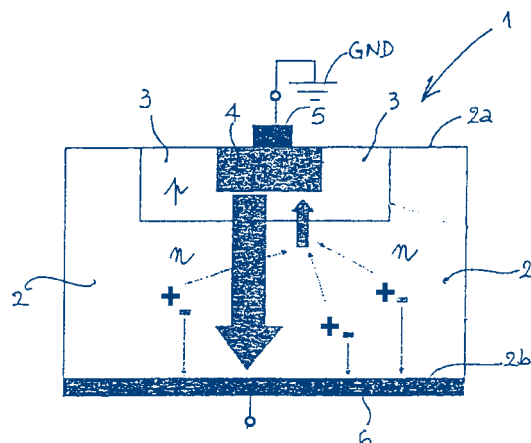
descrizione dell'invenzione (abstract)

Il procedimento comprende le operazioni di predisporre un substrato (2) di materiale semiconduttore monocristallino di tipo (n) ad alta resistività, in particolare silicio, destinato a fungere da collettore, impiantare in una superficie o faccia (2a) di detto substrato (2) uno strato (3) di tipo p destinato a fungere da base, e impiantare uno strato (4) di tipo n destinato a fungere da emettitore in una porzione della superficie libera di detto strato (3) di tipo p, in modo tale per cui il substrato (2) e detti strati (3,4) formano nel complesso un fototransistore bipolare; e stabilire il punto di lavoro di detto fototransistore bipolare (2-4) mediante provvedimenti suscettibili di definire la corrente di base di tale fototransistore (2-4).

¹⁾ In contitolarità con altri Enti

Ufficio Ricerca • Lungarno Pacinotti 43 • 56100 Pisa
e-mail: ricerca@adm.unipi.it • sito web: www.unipi.it/ricerca

disegno



aree di applicazione principali

Esperimenti di fisica delle alte energie, fisica nucleare, fisica della materia, fisica medica, diagnostica industriale, telecomunicazioni, fisica dello spazio (astrofisica), radioprotezione – dosimetria.